

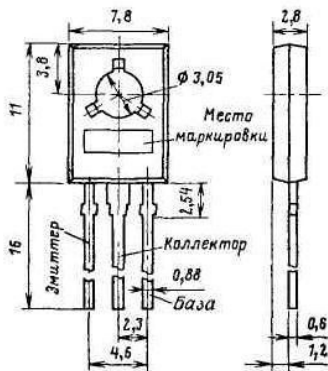
# КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные низкочастотные мощные

Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных схемах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,7 г.



## Электрические параметры

Граничное напряжение при  $I_3 = 100$  мА,  $\tau_n \leq 300$  мкс,  $Q \geq 100$  не менее:

КТ817А	25 В
КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_K = 1$  А,  $I_B = 0,1$  А не более . . . . . 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_K = 1$  А,  $I_B = 0,1$  А не более . . . . . 1,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КЭ} = 2$  В,  $I_3 = 1$  А не менее:  
при  $T = 298$  К и  $T = 373$  К . . . . . 25  
при  $T = 233$  К . . . . . 15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КЭ} = 10$  В,  $I_3 = 0,25$  А не менее . . . . . 3 МГц

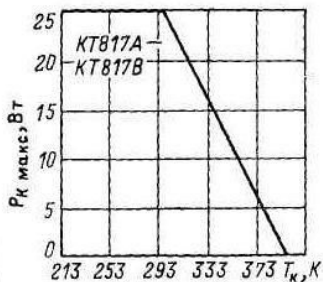
Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ} = 10$  В,  $f = 1$  МГц не более . . . . . 60 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ЭБ} = 0,5$  В не более . . . . . 115 пФ

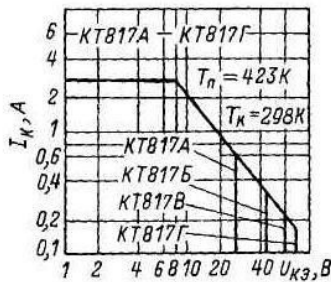
Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = 40$  В КТ817А; при  $U_{КБ} = 45$  В КТ817Б, при  $U_{КБ} = 60$  В КТ817В; при  $U_{КБ} = 100$  В КТ817Г не более:  
при  $T = 233$  и  $298$  К . . . . . 100 мкА  
при  $T = 373$  К . . . . . 3000 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

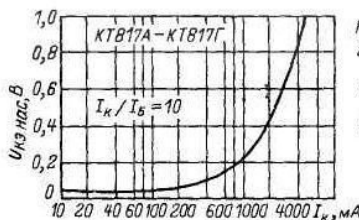
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} = \infty$ ,  $T_K = 233 \div 373$  К:  
КТ817А . . . . . 25 В



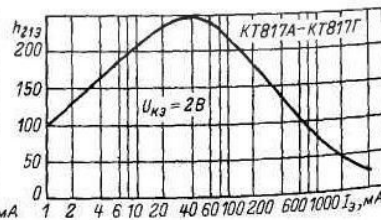
Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса



Область максимальных режимов



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера

КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	80 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} \leq 1$  кОм,  $T_K = 233 - 373$  К

КТ817А	40 В
КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при  $T_K = 233 - 373$  К

Постоянный ток коллектора при  $T_K = 233 - 373$  К . . . . . 5 В

Импульсный ток коллектора при  $\tau_n \leq 20$  мс,  $Q \geq 100$ ,  $T_K = 233 - 373$  К . . . . . 3 А

Постоянный ток базы при  $T_K = 233 - 373$  К . . . . . 6 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при  $T_K = 233 - 298$  К . . . . . 1 А

без теплоотвода при  $T = 233 - 298$  К . . . . . 25 Вт

Температура перехода . . . . . 1 Вт

Температура окружающей среды . . . . . 423 К

Температура окружающей среды . . . . . От 233 до

$T_K = 373$  К

Примечания 1 Постоянная рассеиваемая мощность при  $T_K > 298$  К уменьшается линейно на 0,2 Вт/К с теплоотводом и на 0,01 Вт/К без теплоотвода

2 Пайку выводов разрешается проводить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5-2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус Изгиб в плоскости выводов не допускается

При монтаже транзисторов на теплоотвод крутящий момент при нажатии не должен превышать 70 Н см